



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

HED880

对应国外型号
KSD880

主要用途

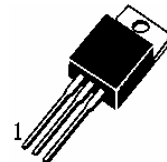
低频功率放大，伴音帧输出及电源调整(与 HEB834 互补)

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极功率耗散 ($T_c=25$)	30W
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	60V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	60V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	7V
I_C ——集电极电流.....	3A
I_B ——基极电流.....	0.3A

外形图及引脚排列

TO-220AB



1—基 极，B
2—集电极，C
3—发射极，E

电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			100	μA	$V_{CB}=60V, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			100	μA	$V_{EB}=7V, I_C=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	60				$I_C=50mA, I_B=0$
$h_{FE(1)}$	直流电流增益	60		300		$V_{CE}=5V, I_C=0.5A$
$h_{FE(2)}$	直流电流增益	20				$V_{CE}=5V, I_C=3A$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压		0.4	1	V	$I_C=3A, I_B=0.3A$
$V_{BE(on)}$	基极—发射极导通电压		0.7	1	V	$V_{CE}=5V, I_C=0.5A$
f_T	特征频率		3		MHz	$V_{CE}=5V, I_C=0.5A$
C_{ob}	共基极输出电容		70		pF	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1.0\text{ MHz}$
t_{on}	导通时间		0.8		μs	$I_{B1}=-I_{B2}=0.2A,$ $V_{CE}=30V$
t_s	载流子贮存时间		1.5		μs	
t_f	下降时间		0.8		μs	

分档及其标志

O

Y

GR

60—120

100—200

150—300



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

HED880

对应国外型号

KSD880

特性曲线

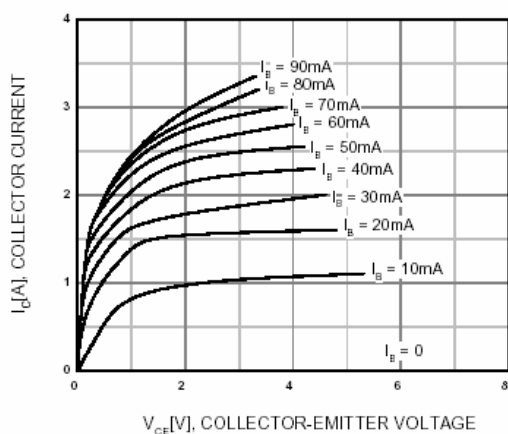


Figure 1. Static Characteristic

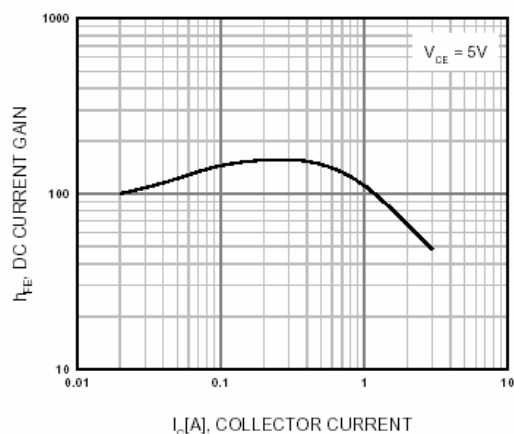


Figure 2. DC current Gain

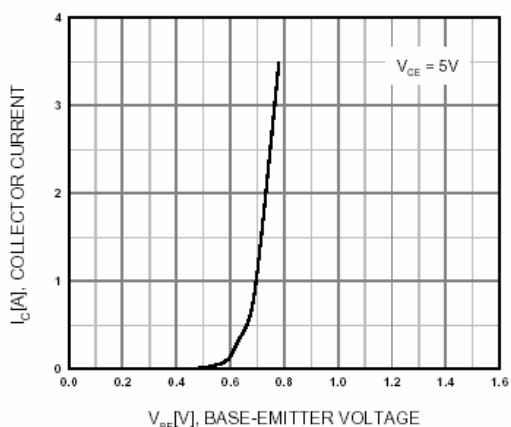


Figure 3. Base-Emitter On Voltage

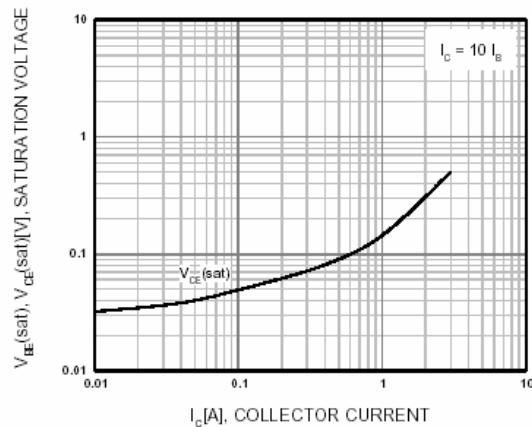


Figure 4. Collector-Emitter Saturation Voltage vs Collector Current

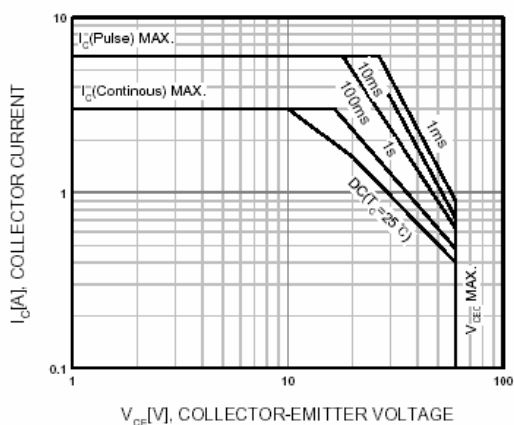


Figure 5. Safe Operating Area

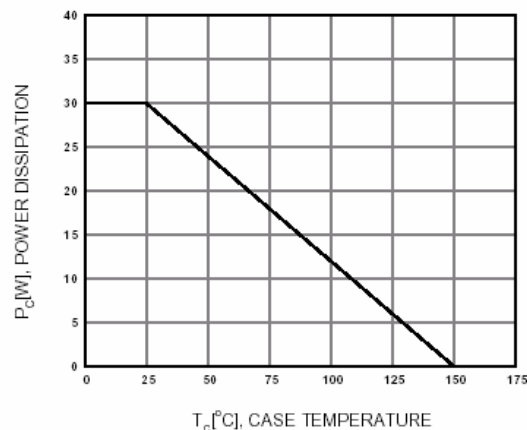


Figure 6. Power Derating